



ДАШЕВСКИЙ ЗИНОВИЙ МОИСЕЕВИЧ

(К 70-летию со дня рождения)

9 февраля 2015 года исполнилось 70 лет академику Международной термоэлектрической академии Дашевскому Зиновию Моисеевичу.

Зиновий Моисеевич Дашевский родился на Украине, в г. Луганске.

Высшее образование получил в России, в Московском институте стали и сплавов, где в 1968 году закончил факультет полупроводников и диэлектриков по специальности “Электротехника”.

В 1973 г. в том же институте защитил кандидатскую диссертацию “Высокоэффективные термоэлектрические пленки на основе твердых растворов *Bi-Te-Sb*”.

На протяжении 1973-1979 гг. З.М. Дашевский работал старшим научным сотрудником, а с 1979 по 1990 гг. – начальником лаборатории пленочных термоэлементов Института источников тока, Научно-производственное Объединение “Квант” (г. Москва).

В 1987 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему “Пленочные термоэлементы: физика и применение” (Санкт-Петербургский технический университет). С 1990 по 1993 год работал начальником отдела термоэлектричества Государственного научно-исследовательского института источников тока (г. Москва), а в 1993 году – генеральным конструктором этого же института. Принимал активное участие в разработке многих термоэлектрических проектов.

На протяжении 1992-1994 гг. занимал должность профессора факультета электроники Московского открытого университета.

С 1994 года по 2013 год З.М. Дашевский – профессор университета им. Бен-Гуриона (г. Бэр Шева, Израиль).

Зиновий Моисеевич успешно занимался преподавательской деятельностью: в Московском открытом университете на факультете электроники читал спецкурс “Электронные материалы”, а в университете им. Бен Гуриона (г. Бэр Шева, Израиль) – курсы “Технология полупроводников”, “Литография и плавление”, “Технология кремниевых СБИС” (для аспирантов).

Основные направления научной работы З.М. Дашевского:

- термоэлектричество;
- полупроводники $A^{IV}-B^{VI}$;
- функционально-градиентные термоэлектрические материалы;
- ИК-детекторы;
- структуры с квантовыми ямами для термоэлектрических применений;
- нанокристаллические полупроводники.

Имя ученого хорошо известно широкой научной общественности. Зиновий Моисеевич – автор известных книг и монографий:

1. Б. Гольцман, З. Дашевский, В. Кайданов и Н. Коломоец. Пленочные термоэлементы: физика и применение (на русском языке). – Г.: Наука, 1985. – 232 с.
2. И. Балмуш, З. Дашевский и А. Касиян. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах (на русском языке). – Кишинев: Штиинца, 1992. – 144 с.
3. З. Дашевский. Термоэлектричество в халькогенидах свинца (глава в книге „Физика и применение полупроводников IV-VI групп”). Под ред. Д.Хохлова. Гордон & Брич, 2002.
4. З. Дашевский. Высокосветочувствительные пленки халькогенидов свинца (глава в справочнике „Полупроводниковые наноструктуры и устройства”). Под ред. А.А. Баландина и К.Л. Ванга. – США, 2005.

Профессор Дашевский на протяжении многих лет руководил научной работой студентов и аспирантов. Под его руководством защищено свыше 7 докторских диссертаций в университете им. Бен-Гуриона.

Дашевский З.М. академик Международной термоэлектрической академии с даты её основания.

В 2009 году Зиновий Моисеевич награждён Почетным Золотым Призом Международной термоэлектрической академии в номинации «За выдающиеся достижения в термоэлектричестве».

Международная термоэлектрическая академия, Институт термоэлектричества НАН и МОН Украины поздравляют Зиновия Моисеевича с юбилеем, желают крепкого здоровья и долголетия.